

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕854号

计划类别：重点产业技术创新->前瞻性应用研究

项目编号：SYG201728

项目名称： 高性能 GaN 基器件无金工艺和 CMOS 绝缘薄膜生长技术研究

承担单位：西交利物浦大学

主管部门：工业园区科技和信息化局

项目合作单位：苏州能讯高能半导体有限公司

项目负责人：刘雯

项目组成员：赵策洲、赵春、蔡玉韬、崔苗、宋晰、
裴晓延、孙瑞泽、朱冀

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
颜波	复旦大学	男	机器学习/模式识别	教授
王明湘	苏州大学	男	微电子	教授
王备新	南京农业大学	男	流域生态学/水质生物监测/昆虫学	教授
李文卫	中国科技大学	男	环境科学	教授
赵宇	浙江大学	男	土木工程/岩土工程	教授

项目验收意见：

受苏州市科技局委托，2019 年 12 月 19 日，苏州工业园区科技和信息化局组织有关专家，对西交利物浦大学承担的“高性能 GaN 基器件无金工艺和 CMOS 绝缘薄膜生长技术研究”（项目编号：SYG201728）项目进行了验收。验收委员会听取了项目汇报，审阅了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目提供的验收资料齐全、规范，符合要求。

2、项目采用无金工艺和 CMOS 绝缘薄膜生长技术制备高性能的 GaN 基电力电子器件，解决了 GaN 无金工艺开发和高品质绝缘栅制备两项关键工艺，技术指标实现了 GaN 器件击穿电压 650V，漏电流小于 10 微安，导通电阻约 0.12 欧姆，阈值电压 1.9 伏。项目执行期内，申请发明专利 4 件，发表 SCI 论文 1 篇，EI 论文 2 篇，培养研究生 4 人，组织学术交流培训会 3 场。

3、项目经费 5 万元，其中市拨经费 5 万元。经费使用合理。

验收委员会认为，项目已完成合同规定的各项指标，一致同意通过验收。